This Page Is Inserted by IFW Operations—and-is-not-a-part-of-the-Official-Record—

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

Abstract of Japanese Patent KOKAI (Laid-Open)

Patent KOKAI (Laid-Open) No.2001-11168

Kokai (Laid-Open) Date: January 16, 2001

Request for Examination: None

Patent Application No.11-188690

Application Date: July 2, 1999

Inventor(s): Takayasu Fujimori et al

Applicant: Mitsubishi Gas Chemical Company Inc.

Title of Invention: Polycarbonate resin

(Names of individuals and corporations have been translated phonetically)

[SUMMARY]

[Subject] To porvide a polycarbonate resin with a lower photoelastic constant than a polycarbonate resin from bisphenol A and good balance of refractive index, Abbe's number and heat resistance.

[Means for solving] A polycarbonate resin derived from pentacyclopentadecanedimethanol, tricyclo(5.2.1.0^{2,6}) decane dimethanol and carbonic acid diester.

(Col.4, lines 40 to 44)

[0014]

In the process for producing the polycarbonate resin of the present invention, basic compounds are used as a catalyst. Such basic compounds include alkaline metal compounds, alkaline earth metal compounds, nitrogen- and phosphorus-containing compounds.

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号 特開2001-11168 (P2001-11168A)

(43)公開日 平成13年1月16日(2001.1.16)

(51) Int.Cl. ⁷				
C 0 8 G 64/30		C 0 8 G 64/30 2 H 0 5 0		
64/02		64/02 4 J 0 2 9		
G 0 2 B 1/04		G O 2 B 1/04 5 D O 2 9		
6/00	391	6/00 3 9 1		
G11B 7/24	5 2 6	G11B 7/24 526G		
	·	審査請求 未請求 請求項の数4 OL (全 6 頁)		
(21) 出願番号	特顯平11-188690	(71) 出顧人 000004466		
		三菱瓦斯化学株式会社		
(22)出願日	平成11年7月2日(1999.7.2)	東京都千代田区丸の内2丁目5番2号		
		(72)発明者 藤森 崇奉		
		茨城県つくば市和台22番地 三菱瓦斯化学		
		株式会社総合研究所内		
		(72)発明者 中村 健一		
		茨城県つくば市和台22番地 三菱瓦斯化学		
		株式会社総合研究所内		
	•	最終頁に続く		

(54) 【発明の名称】 ポリカーポネート樹脂

(57)【要約】

【課題】 ビスフェノールAからのポリカーボネート樹脂と比較して低い光弾性係数を有し、かつ、屈折率とアッベ数と耐熱性のバランスに優れたポリカーボネート樹脂を提供する。

【解決手段】 ペンタシクロペンタデカンジメタノール及びトリシクロ (5. 2. 1. $0^{2,6}$)デカンジメタノールと炭酸ジエステルから誘導されたポリカーボネート樹脂。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 構造式(1)、構造式(2)及び構造式 【化1】

*脂。

(3)で示される構成単位よりなるポリカーボネート樹*

【化2】

(化3)

【請求項2】 ペンタシクロペンタデカンジメタノール 及びトリシクロ(5. 2. 1. $0^{2,6}$)デカンジメタノー ルと炭酸ジエステルを、塩基性化合物の存在下に、溶融 20 重縮合させることを特徴とする請求項1に記載のポリカ ーボネート樹脂の製造方法。

【請求項3】 ペンタシクロペンタデカンジメタノール 及びトリシクロ(5. 2. 1. 0^{2,6})デカンジメタノー ルの合計1モルに対して、10⁻⁹~10⁻³モルの塩基性 化合物触媒を用いる請求項2に記載のポリカーボネート 樹脂の製造方法。

【請求項4】 光学材料に用いることを特徴とする請求 項1に記載のポリカーボネート樹脂。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、透明性、耐熱性、 低い光弾性係数、屈折率およびアッベ数の良好なバラン スを有するポリカーボネート樹脂ならびにその製造方法 に属する。このポリカーボネート樹脂は、光ディスク基 板、各種レンズ、プリズム、光ファイバーなどのプラス チック光学製品の材料に好適に利用できるものである。

[0002]

【従来の技術】2,2-ビス(4-ヒドロキシフェニル)プロ パン(通称:ビスフェノールA)をホスゲンあるいは炭 酸ジエステルと反応させて得られるポリカーボネート樹 脂は、耐熱性及び透明性に優れ、しかも耐衝撃性等の機 械的特性に優れていることから、構造材料はもとより、 光学材料として光ディスク基板、各種レンズ、プリズ ム、光ファイバー等に幅広く利用されている。

【0003】しかし、ビスフェノールAからなるポリカ ーボネート樹脂は、低流動性材料であり、また高い光弾 性係数を有するため、成形時の分子配向や残留応力に伴 う複屈折が大きいという問題点を有している。そのた

め、ビスフェノールAからなるポリカーボネート樹脂を 原材料とする光学材料を成形する場合には、流動性を向 上させるために分子量の比較的低い樹脂を用い、かつ高 温で成形することにより製品の複屈折を低減する方法が 実施されている。しかし、ビスフェノールAからなるポ リカーボネート樹脂では、上記のような手段を用いても 複屈折の低減には限界があるため、近年の光学材料用途 の広がりに伴い、一部光学材料分野、特に光ディスクの 分野では、さらなる低光弾性係数、高流動性材料の開発 が強く求められている。

【0004】ポリカーボネート樹脂の光弾性係数を低下 させる方法としては、例えば、特開昭64-66234 号公報に示されるように、 ピスフェノールAをトリシク ロ (5. 2. 1. 02,6)デカンジメタノールと共重合さ せる方法が公知であるが、耐熱性の低下をもたらし、ま た光弾性係数を低減する上で十分な効果は得られていな

30 【0005】また、レンズ材料、とりわけプラスチック メガネレンズ材料としてはCR-39(ジエチレングリ コールピスアリルカーボネート)が広く用いられている が、屈折率が1.50と低く、また、熱硬化性樹脂であ るため生産性が悪い等の問題点を有しており、これらの 解決が望まれている。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、上記のよう な従来技術に伴う問題点を解決しようとするものであ り、ピスフェノールAからなるポリカーボネート樹脂と 比較して低い光弾性係数を有し、かつ、屈折率とアッベ 数と耐熱性のバランスに優れたポリカーボネート樹脂お よびその製造方法を提供することである。

[0007]

【課題を解決するための手段】本発明者らは、上記の課 題を克服する方法について鋭意研究を重ねた結果、構造 式(1)、構造式(2)及び構造式(3)で示される構 成単位よりなるポリカーボネート樹脂が、上記の課題を 解決できることを見出し本発明に到達した。

【化4】

【化5】

$$-OCH_2 \longrightarrow CH_2OC - (2)$$

【化6】

[0008]

【発明の実施の形態】本発明にかかわるポリカーボネー*

10 * ト樹脂は、ペンタシクロペンタデカンジメタノール及び トリシクロ $(5, 2, 1, 0^{2,6})$ デカンジメタノール と、炭酸ジエステルから誘導されるものである。 【0009】本発明において、ペンタシクロペンタデカ ンジメタノールは、下記の一般式(4)及び(5)で表 されるものであり、種々の異性体を包含する。

【化7】

【化8】

【0010】また、トリシクロ(5.2.1.0^{2,6})デ カンジメタノールは、下記の一般式(6)で表されるも のであり、種々の異性体を包含する。 【化9】

【0011】本発明にかかわるポリカーボネート樹脂 は、ペンタシクロペンタデカンジメタノール及びトリシ クロ (5. 2. 1. 0²,6)デカンジメタノールからそれ ぞれ誘導される構成単位を含有するものであり、トリシ は、トリシクロ $(5, 2, 1, 0^{2,6})$ デカンジメタノー ル及びペンタシクロペンタデカンジメタノールの合計量 に対して、5~70モル%であることが好ましい。トリ シクロ $(5, 2, 1, 0^2, 6)$ デカンジメタノールの含有 率が5モル%未満であると流動性の点から好ましくな く、70モル%を超えると耐熱性の点から好ましくな ٧١_٥

【0012】本発明に用いられる炭酸ジエステルとして は、ジフェニルカーボネート、ジトリールカーボネー ト、ピス(クロロフェニル)カーボネート、ジ**─**罒クレ ジルカーボネート、ジナフチルカーボネート、ジメチル カーボネート、ジエチルカーボネート、ジブチルカーボ 50 ウム、ステアリン酸ナトリウム、ステアリン酸カリウ

ネート、ジシクロヘキシルカーボネート等が挙げらる。 これらの中でも特にジフェニルカーボネートが好まし い。使用する炭酸ジエステルは、トリシクロ(5.2. 1. $0^{2,6}$) デカンジメタノール及びペンタシクロペンタ 30 デカンジメタノールの合計1モルに対して、0.97~ 1. 10モルの比率で用いられることが好ましく、更に 好ましくは0.99~1.04モルの比率である。

【0013】本発明にかかわるポリカーボネート樹脂の ポリスチレン換算重量平均分子量は20,000~20 0,000であることが好ましく、更に好ましくは3 0,000~130,000である。ポリスチレン換算 重量平均分子量が20,000未満では成形体の強度が 不十分となり、200,000を超えると成形時の流動 性が悪くなるため好ましくない。

【0014】本発明にかかわるポリカーボネートの製造 方法では、触媒として、塩基性化合物が用いられる。こ のような塩基性化合物としては、アルカリ金属化合物、 アルカリ土類金属化合物、含窒素化合物及び含リン化合 物等があげられる。

【0015】アルカリ金属化合物としては、具体的に は、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、水酸化セシウ ム、水酸化リチウム、炭酸水素ナトリウム、炭酸ナトリ ウム、炭酸カリウム、炭酸セシウム、炭酸リチウム、酢 酸ナトリウム、酢酸カリウム、酢酸セシウム、酢酸リチ

ム、ステアリン酸セシウム、ステアリン酸リチウム、水 素化ホウ素ナトリウム、フェニル化ホウ素ナトリウム、 安息香酸ナトリウム、安息香酸カリウム、安息香酸セシ ウム、安息香酸リチウム、リン酸水素2ナトリウム、リ ン酸水素2カリウム、リン酸水素2リチウム、フェニル リン酸2ナトリウム、テトラフェニルホウ酸ナトリウ ム、フェノールのナトリウム塩、カリウム塩、セシウム 塩、リチウム塩等が用いられる。

【0016】また、アルカリ土類金属化合物としては、 具体的には、水酸化マグネシウム、水酸化カルシウム、 水酸化ストロンチウム、水酸化バリウム、炭酸水素マグ ネシウム、炭酸水素カルシウム、炭酸水素ストロンチウ ム、炭酸水素バリウム、炭酸マグネシウム、炭酸カルシ ウム、炭酸ストロンチウム、炭酸バリウム、酢酸マグネ シウム、酢酸カルシウム、酢酸ストロンチウム、酢酸バ リウム、ステアリン酸マグネシウム、ステアリン酸カル シウム、ステアリン酸ストロンチウム、ステアリン酸バ リウム、安息香酸カルシウム、フェニルリン酸マグネシ ウム、フェノールのマグネシウム塩、カルシウム塩、ス トロンチウム塩、バリウム塩等が用いられる。

【0017】また、含窒素化合物及び含リン化合物とし ては、具体的には、テトラメチルアンモニウムヒドロキ シド、テトラエチルアンモニウムヒドロキシド、テトラ プロピルアンモニウムヒドロキシド、テトラブチルアン モニウムヒドロキシド、トリメチルベンジルアンモニウ ムヒドロキシド等のアルキル、アリール、アルキルアリ ール基等を有する4級アンモニウムヒドロキシド類、ト リエチルアミン、ジメチルベンジルアミン、トリフェニ ルアミン等の3級アミン類、ジエチルアミン、ジブチル アミン、ジフェニルアミン等の2級アミン類、ブチルア 30 ミン、ペンチルアミン、ヘキシルアミン、デシルアミ ン、アニリン等の1級アミン類、2-メチルイミダゾー ル、2-フェニルイミダゾール、ベンゾイミダゾール等 のイミダゾール類、あるいは、アンモニア、テトラメチ ルアンモニウムボロハイドライド、テトラブチルアンモ ニウムボロハイドライド、テトラブチルアンモニウムテ トラフェニルボレート、テトラフェニルアンモニウムテ トラフェニルボレートおよびテトラフェニルホスホニウ ムテトラフェニルボレート等の塩基性塩等が用いられ る。

【0018】これらの触媒は、ペンタシクロペンタデカ ンジメタノール及びトリシクロ $(5, 2, 1, 0^{2,6})$ デ カンジメタノールの合計1モルに対して、10-9~10 -3モルの比率で、好ましくは 10^{-7} ~ 10^{-4} モルの比率 で用いられる。 10⁻⁹モル未満の場合は充分な重合活性 が得られないため好ましくない。また、10-3を超える と樹脂の着色が著しくなるため好ましくない。

【0019】本発明にかかわるエステル交換反応は、公 知の溶融重縮合法により行うことができる。すなわち、 前記の原料、および触媒を用いて、加熱下に常圧または 50 する方法、あるいは、反応釜から抜き出した樹脂に添加

減圧下にエステル交換反応により副生成物を除去しなが ら溶融重縮合を行うものである。反応は、一般には二段 以上の多段工程で実施される。

【0020】具体的には、第一段目の反応温度は、通常 120~260℃、好ましくは180~240℃であ り、反応時間は、通常0.1~5時間、好ましくは0. 5~3時間である。次いで、反応系の減圧度を上げなが ら反応温度を高めて反応を行い、最終的には1mmHg 以下の減圧下、200~300℃の温度で重縮合反応を 行う。このような反応は、連続式で行ってもよく、また バッチ式で行ってもよい。上記の反応を行うに際して用 いられる反応装置は、錨型攪拌翼、マックスブレンド攪 拌翼、ヘリカルリボン型攪拌翼等を装備した縦型であっ ても、パドル翼、格子翼、メガネ翼等を装備した横型で あってもスクリューを装備した押出機型であってもよい が、連続式の場合は、これらを適宜組み合わせた反応装 置を使用することが好ましい。

【0021】本発明にかかわるポリカーボネート樹脂 は、重合反応終了後、熱安定性および加水分解安定性を 保持するために、触媒を除去もしくは失活させる。一般 20 的には、公知の酸性物質またはその誘導体の添加によ り、触媒を失活させる方法が実施される。これらの酸性 物質またはその誘導体としては、具体的には、pートル エンスルホン酸等の芳香族スルホン酸類、pートルエン スルホン酸ブチル、p-トルエンスルホン酸ヘキシル等 の芳香族スルホン酸エステル類、ドデシルベンゼンスル ホン酸テトラブチルホスホニウム塩等の芳香族スルホン 酸ホスホニウム塩類、ステアリン酸クロライド、塩化ベ ンゾイル、ロートルエンスルホン酸クロライド等の有機 ハロゲン化物、ジメチル硫酸等のアルキル硫酸、塩化ベ ンジル等の有機ハロゲン化物等が好適に用いられる。

【0022】触媒失活後、ポリマー中の低沸点化合物を 0. 1~1 mmHgの圧力、200~300℃の温度で 脱揮除去する工程を設けても良く、このためには、パド ル翼、格子翼、メガネ翼等、表面更新能の優れた攪拌翼 を備えた横型装置、あるいは薄膜蒸発器が好適に用いら れる。

【0023】さらに本発明において、上記熱安定化剤、 加水分解安定剤の他に、酸化防止剤、顔料、染料、強化 剤や充填剤、紫外線吸収剤、滑剤、離型剤、結晶核剤、 可塑剤、流動性改良剤、帯電防止剤、抗菌剤等を添加す ることができる。

【0024】上配添加剤の添加時期は、溶融重縮合で得 られるポリカーボネート樹脂が反応直後の溶融状態にあ るうちに添加しても良く、ポリカーボネート樹脂をペレ ット化した後にあらためて添加しても良い。また、複数 の添加剤を添加時期を変えて添加しても良い。

【0025】反応直後の溶融状態の樹脂に添加剤を添加 する場合には、反応終了後反応釜に直接添加し攪拌混合

7

して横型の混練機に送り込み、均一に混練した後、そのままペレット化する方法が用いられる。あるいは、反応釜から抜き出した樹脂を横型の混練機に送り込み、混練機途中から、添加剤をサイドフィードにより添加し均一に混練した後そのままペレット化する方法が用いられる。

【0026】ペレット化した樹脂に添加剤を添加する場合には、ペレットと上記添加剤とをターンブルミキサーやヘンシェルミキサー、リボンブレンダー、スーパーミキサーで代表される高速ミキサーで分散混合した後、押 10 出機、バンバリーミキサー、ロール等の混練機で溶融混練する方法が適宜選択される。

[0027]

【実施例】以下、実施例により本発明を具体的に説明するが、本発明は、以下の実施例に何ら限定されるものではない。

【0028】 実施例1

ペンタシクロペンタデカンジメタノール49.9g $(0, 19 \pm \nu)$ 、トリシクロ $(5, 2, 1, 0^2, 6)$ デ カンジメタノール2. 0g(0.01モル)、ジフェニ 20 ルカーボネート43.3g(0.202モル)及び炭酸 水素ナトリウム5×10-4g (6×10-6モル) を攪拌 機および留出装置付きの300ml四ッロフラスコに入 れ、窒素雰囲気760mmHgの下180℃に加熱し3 0分間攪拌した。その後、減圧度を150mmHgに調 整すると同時に、60℃/hrの速度で200℃まで昇 温を行い、40分間その温度に保持しエステル交換反応 を行った。さらに、75℃/hrの速度で225℃まで 昇温し、昇温終了の40分後、その温度で保持しなが ら、1時間かけて減圧度を1mmHg以下とした。その 30 後、105℃/hrの速度で235℃まで昇温し合計6 時間攪拌下で反応を行い、反応終了後、反応器内に窒素 を吹き込み常圧に戻し、生成したポリカーボネート樹脂 を取り出した。このポリカーボネート樹脂の物性測定結 果を表1に示す。

【0029】実施例2

実施例1において、ペンタシクロペンタデカンジメタノール36.7g(0.14モル)、トリシクロ(5.2.1.0²,6)デカンジメタノール11.8g(0.06モル)、ジフェニルカーボネート43.3g(0.24002モル)及び炭酸水素ナトリウム5×10⁻⁴g(6×10⁻⁶モル)を使用する以外は、実施例1と同様の操作を行った。得られたポリカーボネート樹脂の物性測定結果を表1に示す。

【0030】実施例3

実施例1において、ペンタシクロペンタデカンジメタノ ール15.7g(0.06モル)、トリシクロ(5. * 2. 1. 0²,6)デカンジメタノール27. 5g(0.14モル)ジフェニルカーボネート43. 3g(0.202モル)及び炭酸水素ナトリウム5×10⁻⁴g(6×10⁻⁶モル)を使用する以外は、実施例1と同様の操作を行った。得られたポリカーボネート樹脂の物性測定結果-を表1に示す。

【0031】比較例1

実施例1において、トリシクロ(5. 2. 1. 0²,6)デカンジメタノール39. 3g(0. 2モル)、ジフェニルカーボネート43. 3g(0. 202モル)及び炭酸水素ナトリウム5×10⁻⁴g(6×10⁻⁶モル)を使用し、ペンタシクロペンタデカンジメタノールを使用しない以外は、実施例1と同様の操作を行った。得られたポリカーボネート樹脂の物性測定結果を表1に示す。

【0032】比較例2

ビスフェノールAからなるポリカーボネート樹脂(三菱エンジニアリングプラスチックス社製、ユービロンHー4000)の物性測定を行った。その結果を表1に示す。

) 【0033】なお、表1中の物性は、下配の方法により 測定したものである。

- 1) 屈折率 (n_D)、アッベ数 (ν_D): ATAGOの 屈折率計により測定した。
- 2) ポリスチレン換算重量平均分子量 (Mw): クロロホルムを展開溶媒としてGPCにより測定した。
- 3) ガラス転移温度 (Tg): 示差走査熱量分析計により測定した。
- 4) 熱分解開始温度(T_d): 熱天秤にて窒素気流中1%重量減少した温度を測定した。 昇温速度は10℃/minである。
- 5) 光弾性係数:エリプソメーターにより、厚さ100 μmのキャストフィルムを用い、レーザー波長633 n mの光をあて、荷重変化に対する複屈折測定から算出し た。
- 6) Q値: 高さ $10 \text{ mm} \times \text{孔} 21 \text{ mm}$ のダイを用い、樹脂温度=240 C、滞留時間=6 min、シリンダ圧力= 160 kgf/cm^2 にて、フローテスターにより測定した。

【0034】また、表1中、化合物名として以下の略号を用いた。

PCPDM :ペンタシクロペンタデカンジメタノール

TCDDM : トリシクロ (5. 2. 1. 0^{2,6})デカンジメタ

H-4000: ピスフェノールAからなるポリカーボネート樹脂

[0035]

表1

9				10	
TCDDM/PCPDM(ENLL)	5/95	30/70	70/30	100/0	H-4000
屈折率(np)	1.537	1.537	1.537	1.537	1.586
アッベ数(vD)	49	49	49	48	30
Mψ	65400	68100	65000	66700	34500
T_g (\mathbb{C})	133	120	100	82	145
-T _d (-C)	334-	330-	332 -	- 334	445
光弹性係数 (10-12m2/N)	12	12	12	13	78
Q値(cm ³ /sec)	0.10	0.15	0.24	0.32	0.094

[0036]

【発明の効果】本発明によるポリカーボネート樹脂は、 優れた透明性、耐熱性、耐衝撃性、良好な屈折率-アッ べ数バランス、低い光弾性係数等の特性を有する新規な*

10*脂肪族ポリカーボネート樹脂であり、光ディスク基板を 始め各種レンズ、プリズム、光ファイバー等のプラスチ ック光学製品の材料として極めて有用に利用できる。

フロントページの続き

Fターム(参考) 2H050 AB42Z

4J029 AA09 AB01 AC02 AD01 AE04
AE05 BD05A HA01 HC03
HC04A HC05A HC05B JA091
JA121 JA171 JA261 JB171
JB201 JC031 JC041 JC061
JC091 JC261 JC451 JC581
JC731 JF011 JF021 JF031
JF041 JF131 JF141 JF151

JF161 KB05 KE05 5D029 KA08 KC04 KC06 KC13